

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4990439号
(P4990439)

(45) 発行日 平成24年8月1日(2012.8.1)

(24) 登録日 平成24年5月11日(2012.5.11)

(51) Int.Cl.	F 1
B06B 1/06 (2006.01)	B06B 1/06 A
B08B 3/12 (2006.01)	B08B 3/12 Z
H01L 21/304 (2006.01)	H01L 21/304 642 E

請求項の数 5 (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願2001-50575 (P2001-50575)
 (22) 出願日 平成13年2月26日 (2001.2.26)
 (65) 公開番号 特開2002-248429 (P2002-248429A)
 (43) 公開日 平成14年9月3日 (2002.9.3)
 審査請求日 平成20年2月26日 (2008.2.26)

特許法第30条第1項適用 2000年9月3日 (社
) 応用物理学会発行の「2000年(平成12年)秋季
 第61回応用物理学会学術講演会 講演予稿集 第2
 分冊」に発表

前置審査

(73) 特許権者 000002428
 芝浦メカトロニクス株式会社
 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目5番1号
 (73) 特許権者 000003078
 株式会社東芝
 東京都港区芝浦一丁目1番1号
 (74) 代理人 100091351
 弁理士 河野 哲
 (74) 代理人 100088683
 弁理士 中村 誠
 (74) 代理人 100084618
 弁理士 村松 貞男

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】超音波発振装置及び超音波発振方法、洗浄装置及び洗浄方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

それぞれ異なる高周波信号を出力する複数の高周波発振手段と、
 前記複数の高周波信号から一つ或いは複数の高周波信号を選択する選択手段と、
 選択された高周波信号により振動子を振動させる高周波発振器を有し、
 前記複数の高周波発振手段は、所定周波数の信号を異なる周波数の高周波信号に変調する複数の変調手段であって、

前記複数の高周波信号を上記選択手段により選択する際の変調速度を制御する制御手段を備え、

上記複数の高周波信号の変調幅は10kHz以上で、上記制御手段によって制御される変調速度は5kHz以上であることを特徴とする超音波発振装置。

10

【請求項2】

前記複数の高周波発振手段から出力される高周波信号の振幅幅は、前記振動子の共振周波数から反共振周波数の範囲内とすることを特徴とする請求項1記載の超音波発振装置。

【請求項3】

振動子を振動させるための複数の異なる周波数の高周波信号を発生する超音波発振方法において、

上記複数の高周波信号の変調幅は10kHz以上で、その周波数の変調速度は5kHz以上で制御することを特徴とする超音波発振方法。

【請求項4】

20

被洗浄物を洗浄液によって洗浄する洗浄装置であって、
上記洗浄液に超音波振動を付与するための高周波信号を出力する超音波発振装置を備え

この超音波発振装置は請求項 1 に記載された構成であることを特徴とする洗浄装置。

【請求項 5】

被洗浄物を洗浄液によって洗浄する洗浄方法であって、

上記洗浄液に請求項 1 に記載された超音波発振装置から出力された高周波信号によって
超音波振動を付与することを特徴とする洗浄方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

10

【発明の属する技術分野】

この発明は振動子を高周波振動させるための超音波発振装置及び超音波発振方法、洗浄装置及び洗浄方法に関する。

【0002】

20

【従来の技術】

たとえば、液晶表示装置や半導体装置の製造工程においては、ガラス基板や半導体ウエハなどの被洗浄物を高い清浄度で洗浄することが要求される工程がある。上記被洗浄物を洗浄する方式としては、洗浄液中に複数枚の被洗浄物を浸漬するディップ方式や被洗浄物に向けて洗浄液を噴射して一枚づつ洗浄する枚葉方式があり、最近では高い清浄度が得られるとともに、コスト的に有利な枚葉方式が採用されることが多くなってきている。

【0003】

枚葉方式の 1 つとして被洗浄物に噴射される洗浄液に超音波振動を付与し、その振動作用によって上記被洗浄物からパーティクルを効率よく除去するようにした洗浄方式が実用化されている。

【0004】

洗浄液に付与する振動は、従来は 20 ~ 400 kHz 程度の周波数が一般的であったが、ガラス基板や半導体ウエハなどの精密洗浄の分野では 600 ~ 3000 kHz 程度の周波数が用いられている。

【0005】

超音波洗浄装置は、上述した周波数の音波を発生させるための高周波信号を出力する高周波発振器を備えており、この高周波発振器から出力される高周波信号によって振動子が駆動されるようになっている。そして、振動子の振動は洗浄液に付与され、被洗浄物が超音波洗浄されるようになっている。

30

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、近年の精密洗浄においては、ガラス基板や半導体ウエハの被洗浄物に形成されるパターンの微細化などに伴い洗浄液に付与された超音波によって配線などのパターンがダメージを受けるという問題が発生している。

【0007】

配線などに与えるダメージを低減する対策として発振出力を低出力化することが考えられる。しかしながら、発振出力を低出力化すると、洗浄効果も低下するため、実用的でないということがある。

40

【0008】

この発明は、洗浄効果を低下させることなく、被洗浄物に与えるダメージを低減することができるようとした超音波発振装置及び超音波発振方法、洗浄装置及び洗浄方法を提供することにある。

【0009】

請求項 1 の発明は、それぞれ異なる高周波信号を出力する複数の高周波発振手段と、
前記複数の高周波信号から一つ或いは複数の高周波信号を選択する選択手段と、
選択された高周波信号により振動子を振動させる高周波発振器を有し、

50

前記複数の高周波発振手段は、所定周波数の信号を異なる周波数の高周波信号に変調する複数の変調手段であって、

前記複数の高周波信号を上記選択手段により選択する際の変調速度を制御する制御手段を備え、

上記複数の高周波信号の変調幅は10kHz以上で、上記制御手段によって制御される変調速度は5kHz以上であることを特徴とする超音波発振装置にある。

【0012】

請求項2の発明は、前記複数の高周波発振手段から出力される高周波信号の振幅幅は、前記振動子の共振周波数から反共振周波数の範囲内とすることを特徴とする請求項1記載の超音波発振装置にある。 10

【0014】

請求項3の発明は、振動子を振動させるための複数の異なる周波数の高周波信号を発生する超音波発振方法において、

上記複数の高周波信号の変調幅は10kHz以上で、その周波数の変調速度は5kHz以上で制御することを特徴とする超音波発振方法にある。

請求項4の発明は、被洗浄物を洗浄液によって洗浄する洗浄装置であって、

上記洗浄液に超音波振動を付与するための高周波信号を出力する超音波発振装置を備え、

この超音波発振装置は請求項1に記載された構成であることを特徴とする洗浄装置にある。 20

請求項5の発明は、被洗浄物を洗浄液によって洗浄する洗浄方法であって、

上記洗浄液に請求項1に記載された超音波発振装置から出力された高周波信号によって超音波振動を付与することを特徴とする洗浄方法にある。

【0015】

この発明によれば、予め所定の周波数に変調された複数の高周波信号を選択し、洗浄液に付与される超音波振動の周波数を変化させることで、洗浄効果を低下させずに被洗浄物に与えるダメージを低減することができ、しかも高周波信号の周波数の切り換えを高速度で行うことが可能となる。

【0016】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の一実施の形態を図面を参照して説明する。 30

【0017】

図1と図2に示すこの発明の超音波発振装置は高周波発振器31を有し、この高周波発振器31にはマッチング回路部27を介して高周波洗浄機10が接続されている。

【0018】

図2に示すように、上記高周波洗浄機10は本体11を有する。この本体11は上面が開放した凹部12が長手方向に沿って形成された上部材13と、この上部材13の下面に第1のシル材14を介して液密に接合固定された下部材15とによって細長い角柱状に形成されている。

【0019】

上記上部材13の下部壁の幅方向中央部分には長手方向に沿って嵌合孔16が穿設され、上記下部材15の上面の幅方向中央部分には上記嵌合孔16に嵌合する凸部17が形成されている。 40

【0020】

上記下部材15の凸部17が形成された幅方向中央部分には、一端を上面に開口させ、他端を下面に開口させた空間部18が長手方向に沿って形成されている。この空間部18の断面形状は、一端(上端)から他端(下端)にゆくにつれて幅寸法が小さくなるテ-バ状をなしていて、その下端開口は上端よりも狭幅となったノズル口19に形成されている。上記空間部18には、上記下部材15に形成された一対の供給路20から洗浄液が供給されるようになっている。 50

【 0 0 2 1 】

上記空間部 1 8 の開口した上端はタンタル、チタンあるいはそれらの合金や石英、サファイアなどによって矩形板状に形成された振動板 2 1 によって液密に閉塞されている。つまり、この振動板 2 1 は、その下面周辺部が所定の厚さを有する枠状の第 2 のシ - ル材 2 2 を介して上記上部材 1 3 の凹部 1 2 の内底面に接合されている。

【 0 0 2 2 】

上記振動板 2 1 の上面には同じく枠状の押え板 2 3 が接合され、上記上部材 1 3 にねじ 2 0 a によって固定されている。それによって、上記空間部 1 8 の上端開口は液密に閉塞されている。

【 0 0 2 3 】

上記振動板 2 1 の上面の幅方向中央部分、つまり上記空間部 1 8 と対応する部位には振動子 2 4 が上記振動板 2 1 の長手方向に沿って取着されている。この振動子 2 4 には、たとえばインピーダンスが 5 0 Ω の第 1 の同軸ケ - ブル 2 5 a の芯線の一端が電気的に接続されている。この第 1 の同軸ケ - ブル 2 5 a の他端には第 1 のソケット 2 6 a が設けられ、この第 1 のソケット 2 6 a はマッチング回路部 2 7 の一端に設けられた第 1 のポ - ト 2 7 a に着脱自在に接続される。なお、第 1 の同軸ケ - ブル 2 5 a の被覆線はア - スされている。

10

【 0 0 2 4 】

上記マッチング回路部 2 7 の他端には第 2 のポ - ト 2 7 b が設けられ、この第 2 のポ - ト 2 7 b には第 2 の同軸ケ - ブル 2 5 b の一端に設けられた第 2 のソケット 2 6 b が着脱自在に接続される。この第 2 の同軸ケ - ブル 2 5 b の他端は上記高周波発振器 3 1 に接続される。この高周波発振器 3 1 は図 3 に示すように周波数シンセサイザ 3 2 を有する。この周波数シンセサイザ 3 2 からは所定の周波数の波形が出力されるようになっていて、その周波数は制御部としての C P U 3 3 によって変換制御されるようになっている。

20

【 0 0 2 5 】

上記周波数シンセサイザ 3 2 から出力された所定周波数の波形は、高周波パワ - アンプ 3 4 で増幅され、上記第 2 の同軸ケ - ブル 2 5 b の電圧、電流をモニタする C M カップラ - (通過形電力計) 3 5 で出力がモニタ - されて上記マッチング回路部 2 7 へ出力される。

【 0 0 2 6 】

図 4 に上記高周波発振器 3 1 の詳細な構成を示す。つまり、電源 4 1 からの交流 1 0 0 V はフィルタ 4 2 によって雑音を除去されてからヒューズ 4 3 、電源スイッチ 4 4 、ブレーカー 4 5 を介して交流 1 0 0 V を全波整流する整流器 4 6 に入力する。

30

【 0 0 2 7 】

整流器 4 6 で全波整流された信号は電解コンデンサー 4 7 に入力する。この電解コンデンサー 4 7 には第 1 のスイッチ 4 8 が設けられている。この第 1 のスイッチ 4 8 は上記 C P U 3 3 によって連続側とパルス側とに自動的に切り換え操作されるようになっていて、パルス側に切り換えると全波整流された信号は電解コンデンサー 4 7 をパスするため、パルス波形となって上記パワーアンプ 3 4 に入力し、連続側に切り換えると電解コンデンサー 4 7 によって連続波形に変換されて上記パワーアンプ 3 4 に入力するようになっている。

【 0 0 2 8 】

40

上記パワーアンプ 3 4 にはボリューム 3 4 a が接続されているとともに、高周波成分を作り出す複数、この実施の形態では第 1 の P L L 回路 5 1 A と第 2 の P L L 回路 5 1 B とが上記 C P U 3 3 によって切り換え制御される選択スイッチ 4 9 を介して接続されている。

【 0 0 2 9 】

上記第 1 の P L L 回路 5 1 A には第 2 のスイッチ 5 2 a が接続され、第 2 の P L L 回路 5 1 B には第 3 のスイッチ 5 2 b が接続されている。この第 2 、第 3 のスイッチ 5 2 a , 5 2 b は第 1 、第 2 の P L L 回路 5 1 A 、 5 1 B から上記パワーアンプ 3 4 へ出力される高周波信号の発振周波数を設定するためのもので、この実施の形態では第 1 の P L L 回路 5 1 A から出力される発振周波数が 1 6 0 0 k H z 、第 2 の P L L 回路 5 1 B から出力される発振周波数が 1 5 9 0 k H z に設定されている。

50

【 0 0 3 0 】

上記選択スイッチ 4 9 は上記 C P U 3 3 によって切り換え制御されるようになっており、この選択スイッチ 4 9 が切り換えられるとともに、その信号が第 1 の P L L 回路 5 1 A または第 2 の P L L 回路 5 1 B に入力されると、上記第 1 の P L L 回路 5 1 A または第 2 の P L L 回路 5 1 B からは 1 6 0 0 k H z または 1 5 9 0 k H z の高周波信号がパワーアンプ 3 4 に即時に出力されるようになっている。このときの選択スイッチ 4 9 の切り換え速度が周波数の切り換え速度、つまり変調速度になる。後述する実験でも確認されているが、変調速度を早くする程、被洗浄物に生じる欠陥（クラック）が少なくなる。

【 0 0 3 1 】

各 P L L 回路 5 1 A , 5 1 B が接続された C P U 3 3 には、上記パワーアンプ 3 4 から出力される高周波信号の発振時間及び発振間隔（デューティ比）を制御する第 4 のスイッチ 5 3 が設けられている。この第 4 のスイッチ 5 3 によって高周波信号のデューティ比を制御することができる。10

【 0 0 3 2 】

つまり、パワーアンプ 3 4 から連続波を出力するときに、第 4 のスイッチ 5 3 によって設定されるデューティ比が 0 であれば連続波となるが、デューティ比を所定の値に設定すれば、図 5 (f) に示すように連続波を所定の周期で分割したバースト波を得ることができる。また、パワーアンプ 3 4 からパルス波を出力するときに、第 4 のスイッチ 5 3 によってデューティ比を変化させれば、このパルス波のパワーレベルを調整することができるようになっている。20

【 0 0 3 3 】

上記パワーアンプ 3 4 からの高周波信号は V S W R 回路 5 4 を通じて出力されるとともに、この高周波信号の進行波と反射波は上記 V S W R 検出器 5 4 によって検出される。この V S W R 検出器 5 4 からの検出信号は演算回路 5 5 で演算処理されて上記パワーアンプ 3 4 及び C P U 3 3 にフィードバックされる。パワーアンプ 3 4 では、演算回路 5 5 からの信号によってボリューム 3 4 a の設定に基づき上記パワーアンプ 3 4 から発振される高周波信号の強さを補正するようになっている。

【 0 0 3 4 】

さらに、各 P L L 回路 5 1 A , 5 1 B にはそれぞれ第 5 , 第 6 のスイッチ 5 6 a , 5 6 b を介して低周波発振回路 5 7 が接続されている。上記第 5 のスイッチ 5 6 a 又は第 6 のスイッチ 5 6 b のいずれかを選択的にオンすると、ポテンショメータ 5 8 によって上記低周波発振回路 5 7 で作られた所定の周波数の信号が上記第 1 又は第 2 の P L L 回路 5 1 A , 5 1 B に入力され、 1 6 0 0 k H z 又は 1 5 9 0 k H z の高周波信号に周波数変調されるようになっている。30

【 0 0 3 5 】

この実施の形態では、第 1 の P L L 回路 5 1 a と第 2 の P L L 回路 5 1 b とにおける変調幅を 1 0 k H z としたが、この変調幅は上記振動子 2 4 の共振周波数と反共振周波数の範囲内である。

【 0 0 3 6 】

それによって、振動子 2 4 のインピーダンス特性が部分的に不均一であっても、この振動子 2 4 から出力される高周波振動の音圧を均一化できるようになっている。40

【 0 0 3 7 】

つまり、振動子 2 4 は、通常、粉末のセラミック原料を圧縮成形してから焼成して製造されるため、その全領域においてインピーダンス特性が一定になりにくい。そのため、振動子 2 4 の全領域に所定の周波数の高周波信号を一様に供給しても、出力が一定にならないということがある。

【 0 0 3 8 】

しかしながら、振動子 2 4 に供給する高周波信号を所定の周波数の範囲で周波数変調することで、振動子 2 4 の全領域におけるインピーダンス特性が一定でなくとも、各領域にインピーダンス特性に応じた周波数の高周波信号を供給することができる。それによって、50

振動子 24 から出力される超音波の強さをほぼ均一化することができる。

【0039】

図4に示すように、上記高周波発振器31には時間計61及びリレー回路62が設けられている。時間計61は発振時間を計測するとともに、その計測時間をリセットするリセットスイッチ63が設けられ、リレー回路62は複数のランプ64によって各種の表示を行うようになっている。

【0040】

なお、上記第1乃至第6のスイッチ48, 52a, 52b, 53, 56a, 56bの動作は、上記CPU33によって自動的に動作させることができるようになっている。

【0041】

また、上記電源41からの信号の一部は、高周波発振器31を冷却するためのファン65及びCPU33を駆動するために交流電圧を直流電圧に変換するコンバータ66に入力されるようになっている。

【0042】

つぎに、上記超音波発振装置を用いて図5(a)~(f)に示す波形の高周波信号を発振出力する場合について説明する。

【0043】

まず、図5(a)に示す第1の波形71の高周波信号を出力する場合には、電源スイッチ44をオンにして電源を入れたならば、CPU33によって第1の波形71が出力される状態に設定する。CPU33の設定に基づき、第1のスイッチ48は発振動作が開始される発振初期時にはパルス側に切り換わり、パルス発振（この実施の形態では1パルス発振）が終了すると同時に連続側に切り換わる。

【0044】

それによって、第1のスイッチ48がパルス側に切り換わった発振初期時には整流器46で全波整流された信号が電解コンデンサー47をパスするため、パワーアンプ34からは第2のスイッチ52によって設定された周波数の高周波信号がパルス発振されることになる。

【0045】

高周波信号のパルス発振が終了すると、第1のスイッチ48が連続側に切り換わるから、整流器46で全波整流された信号は電解コンデンサー47で平滑化されてパワーアンプ34に入力する。

【0046】

それによって、電解コンデンサー47からの信号は、パルス発振よりも低いパワーレベルで連続発振することになる。つまり、第1の波形71は発振の初期にはパルス発振で、その後は連続発振となる。

【0047】

このような第1の高周波信号の波形を振動子24に入力すれば、被洗浄物を最初は高いパワーのパルス発振で洗浄でき、その後はパワーの低い連続発振で所定時間洗浄することができる。

【0048】

そのため、最初のパルス発振によって被洗浄物からは比較的強固に付着して落ち難い状態であったり、粒径が大きなパーティクルを除去することができ、次に連続発振を所定時間継続して行うことで、被洗浄物に通常の状態で付着したり、比較的粒径の小さなパーティクルなど、短時間で除去できなかったパーティクルを確実に除去することができる。

【0049】

図5(b)に示す第2の波形72の高周波信号の波形を出力する場合には、CPU33によって第2の波形が出力される状態に設定する。CPU33の設定に基づき発振動作が開始されると、まず、第1のスイッチ48は発振動作が開始してから所定時間経過するまでは連続側に切り換えられる。

【0050】

10

20

30

40

50

それによって、整流器46で全波整流された信号は連続発振する。連続発振が所定時間行われると、第1のスイッチ48がパルス側に切り換えられるから、整流器46で全波整流された信号は電解コンデンサー47をパスして所定の周波数でパルス発振する。

【0051】

したがって、このような発振波形によれば、所定時間の連続発振によって被洗浄物に付着したほとんどのパーティクルは除去されるものの、連続発振では除去されないパーティクルが最後のパルス発振によって除去されることになるから、この場合も第1の波形と同様、被洗浄物に付着したパーティクルの付着状態や大きさなどが一定でなくとも、十分な洗浄効果を得ることができる。

【0052】

図5(c)に示す第3の波形73の高周波信号の波形を出力する場合には、CPU33によって第3の波形73が outputされる状態に設定する。CPU33の設定に基づき発振が開始されると、第1のスイッチ48は上記CPU33からの制御信号によって所定時間ごとに連続側からパルス側に切り換えられる。

【0053】

それによって、第3の高周波信号の波形73は、パルス発振と連続発振とが繰り返されることになるから、被洗浄物に比較的除去し難いパーティクルが多く付着している場合に、この第3の波形73を適用すれば、パルス発振だけで被洗浄物を洗浄する場合に比べて被洗浄物に衝撃を与え過ぎることなく、洗浄効果を高めることができる。

【0054】

図5(d)に示す第4の波形74は連続波であって、この波形を出力するよう、CPU33を設定すると、第1のスイッチ48は連続側に切り換えられる。それによって、整流器46で全波整流された信号は電解コンデンサー47で平滑化されてパワーアンプ34に入力するから、所定の周波数によって連続発振が行われる。

【0055】

第4の波形74である連続波を発振させる場合に、第4のスイッチ53によってデューティ比を0から所定の値に設定すれば、図5(f)に示すように、連続波が所定の周期で分断されたバースト波を得ることができる。この周期はデューティ比によって任意に設定することができる。なお、図5(f)の波形を第6の波形76とする。

【0056】

図5(e)に示す第5の波形75はパルス波であって、この波形を出力するよう、CPU33を設定すると、第1のスイッチ48はパルス側に切り換えられる。それによって、整流器46で全波整流された信号は電解コンデンサー47をパスしてパワーアンプ34に入力するから、所定の周波数によってパルス発振が行われる。

【0057】

第5の波形75であるパルス波を発振させる場合に、第4のスイッチ53によってデューティ比を所定の値に設定すれば、パルス波の出力レベルを調整することができるから、被洗浄物の汚れ状態に適した出力レベルで被洗浄物を洗浄することができる。

【0058】

このように、第1のスイッチ48の切り換えをCPU33によって制御することで、パルス波と連続波を組み合わせた発振波形を得ることができるから、被洗浄物に付着したパーティクルの種類や大きさなどに応じて発振波形を設定すれば、洗浄効果を向上させることができる。

【0059】

しかも、パルス波と連続波とを組み合わせた第1乃至第3の波形71~73だけでなく、連続波だけの第4の波形74やパルス波だけの第5の波形75を発振させることができるとから、第1乃至第3の波形で対応できない場合にも、対応することが可能となる。

【0060】

さらに、第4のスイッチ53によってデューティ比を設定すれば、連続波を発振させるとときには、連続波からバースト波を得ることができ、パルス波を発振させるとときには、その

10

20

30

40

50

パルス波の出力レベルを変えることができるから、そのことによっても種々の洗浄条件に対応した発振波形を設定することができる。

【0061】

第1乃至第6の波形で高周波信号を発振させる場合、パワーアンプ34から発振出力される高周波信号を変調することができる。すなわち、この実施の形態の場合、CPU33によって第5のスイッチ56aと第6のスイッチ56bとをオンにしておくとともに、選択スイッチ49を所定の速度で切り換える。

【0062】

選択スイッチ49が第1のPLL回路51A側に切り換えられると、この第1のPLL回路51Aによって作られた1600kHzの高周波信号がパワーアンプ34を通じてVSWR検出器54から出力され、選択スイッチ49が第2のPLL回路51B側に切り換えられると、この第2のPLL回路51Bによって作られた1590kHzの高周波信号がパワーアンプ34を通じてVSWR検出器54から出力される。

10

【0063】

つまり、周波数が1600kHzの高周波信号と、1590kHzの高周波信号、すなわち変調幅が10kHzの2つの高周波信号を、切り換えスイッチ49の切り換え速度に応じた変調速度で出力することができる。切り換えスイッチ49の切り換えは、CPU33によって高速度で行うことが可能であり、それによって周波数の切り換えを連続的に行えるため、被洗浄物に与えるダメージを低減することが可能となる。

【0064】

20

図6と図7とに洗浄液に与える変調幅、変調速度とを変化させたときに、半導体ウエハに生じるクラックなどの欠陥及び半導体ウエハに塗布されたPSL（ポリスチレン系ラテックス）の除去率を測定したこの発明の実験結果を示す。

【0065】

なお、実験条件としては、半導体ウエハ直径が200mm、MHz出力は60Wで固定した。また、洗浄液は純水である。

【0066】

図6は変調速度を10kHzに固定し、変調幅を0から、すなわち周波数1590kHzから徐々に増加した場合であって、同図に線Aで示すように、変調幅が0のとき、つまり1590kHzの高調波信号を変調させずに洗浄液に付与して半導体ウエハを洗浄した場合、この半導体ウエハには527個のクラックなどの欠陥が計測された。変調幅を1kHzとすると、欠陥数が17個となり、10kHz以上の変調幅となると、欠陥数は2~7個に低減した。

30

【0067】

同図において、線Bは半導体ウエハに塗布されたPSLの除去率で、この除去率は変調幅にほとんど影響を受けることなく、99.4%以上であった。

【0068】

図6に示す実験から明らかなように、洗浄液に付与する高周波信号の変調速度を10kHzで固定し、周波数を変調させると、半導体ウエハに生じる欠陥数を大幅に低減することができ、とくにその変調幅を10kHz以上にすると、欠陥数の減少が顕著になることが確認された。しかも、MHz出力を60Wで固定したことで、洗浄効果を低下させることなく、半導体ウエハに生じる欠陥数を低減することができた。

40

【0069】

図7は変調幅を10kHzに固定し、変調速度を0kHzから徐々に増加した場合であって、同図に線Cで示すように変調速度が0の場合は半導体ウエハに527個の欠陥が生じたが、変調速度を徐々に増加させることで、その欠陥数は激減し、0.5kHzでは95個、2.5kHzでは52個が計測され、5kHz以上では0~2個になった。

【0070】

同図において、線DはPSLの除去率で、この除去率は変調速度にほとんど影響を受けることなく、99.4%以上であった。

50

【0071】

図7に示す実験から明らかなように、洗浄液に付与する高周波信号の変調幅を10kHzに固定して変調速度を変化させることで、半導体ウエハに生じる欠陥数を大幅に低減することができ、とくにその変調速度を5kHz以上にすると、欠陥数の減少が顕著になることが確認された。しかも、MHz出力を60Wで固定したことで、洗浄効果を低下させることなく、半導体ウエハに生じる欠陥数を低減することができた。

【0072】

これらの実験から明らかなように、洗浄液に付与する高周波信号の周波数を変調させるとともに、その周波数の変調速度を変化させることで、半導体ウエハに欠陥をほとんど生じさせることなく、高い洗浄効果を得ることができることが確認された。とくに、変調幅を10kHz以上、変調速度を5kHz以上とすることで、その効果が顕著になることがわかった。10

【0073】

このような洗浄効果を得られる理由としては、周波数を変調させると、半導体ウエハが不定周期の振動によって洗浄されることになるから、半導体ウエハが高周波信号の周波数と共に共振して欠陥が発生するのを防止することができる。

【0074】

しかも、周波数の変調を第1、第2のPLL回路51A, 51Bの切り換えによって高速度で行えるから、そのことにより、周波数の切り換えが連続的になる。そのため、周波数の切り換え時に半導体ウエハに与える衝撃を減少させ、欠陥の発生を防止することができるためであると考えられる。20

【0075】

この発明は上記一実施の形態に限定されず、種々変形可能である。たとえば、上記一実施の形態では第1、第2のPLL回路によって高周波信号を1590kHzと1600kHzとに変調したが、3つ以上のPLL回路を設けることで、1590kHzと1600kHz以外の高周波信号に変調して出力できるようにしてもよい。

【0076】

なお、上記一実施の形態では半導体ウエハなどの被洗浄物を1枚づつ洗浄する枚葉方式に本件の発明を適用する場合について説明したが、複数枚の被洗浄物を洗浄槽に入れて同時に洗浄するバッチ方式にも本件発明を適用することができる。30

【0077】**【発明の効果】**

以上のようにこの発明は、予め所定の周波数に変調された複数の高周波信号を選択し、洗浄液に付与される高周波信号の周波数を変化させることができるようにした。

【0078】

そのため、洗浄効果を低下させずに被洗浄物に与えるダメージを低減することができ、しかも高周波信号の周波数の切り換えを高速度で行うことが可能となる。

【0079】

また、高周波信号の周波数の切り換えとともに、その周波数の切り換え速度を変調されれば、被洗浄物に生じる欠陥をより一層、低減することができる。40

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施の形態を示す超音波発振装置の構成図。

【図2】超音波洗浄機の断面図。

【図3】高周波発振器の概略図。

【図4】高周波発振器の回路図。

【図5】高周波発振器によって得られる波形の説明図。

【図6】変調速度を一定にし、変調幅を変化させたときの半導体ウエハに生じる欠陥数と汚れの除去率を測定したグラフ。

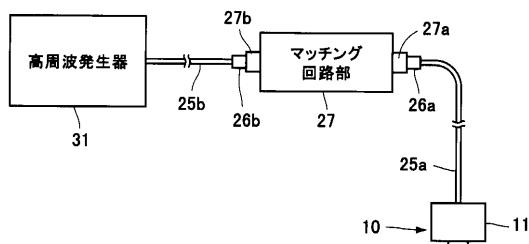
【図7】変調幅を一定にし、変調速度を変化させたときの半導体ウエハに生じる欠陥数と汚れの除去率を測定したグラフ。50

【符号の説明】

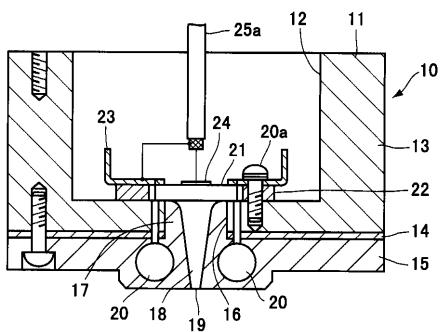
- 3 1 ... 高周波発振器
 3 3 ... C P U (制御部)
 4 8 ... 第 1 のスイッチ
 4 9 ... 選択スイッチ
 5 1 A ... 第 1 の P L L 回路
 5 2 B ... 第 2 の P L L 回路
 5 2 a ... 第 2 のスイッチ
 5 2 b ... 第 3 のスイッチ
 5 3 ... 第 4 のスイッチ
 5 6 a ... 第 5 のスイッチ
 5 6 b ... 第 6 のスイッチ

10

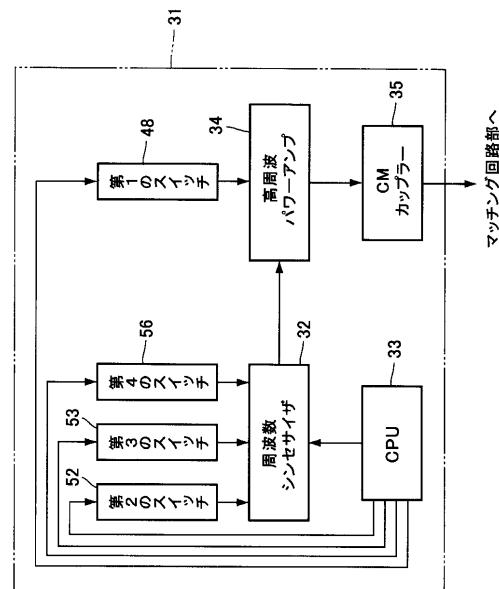
【図 1】



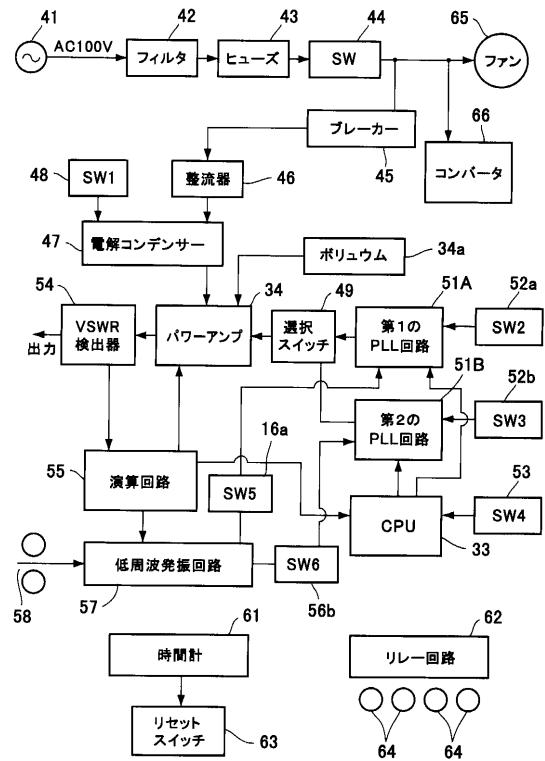
【図 2】



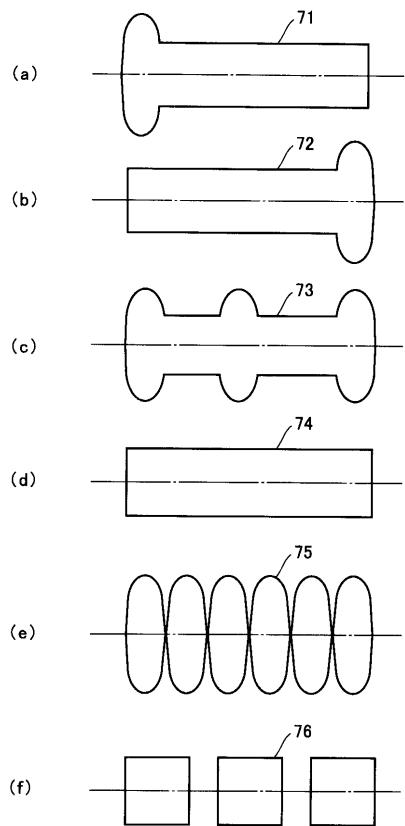
【図 3】



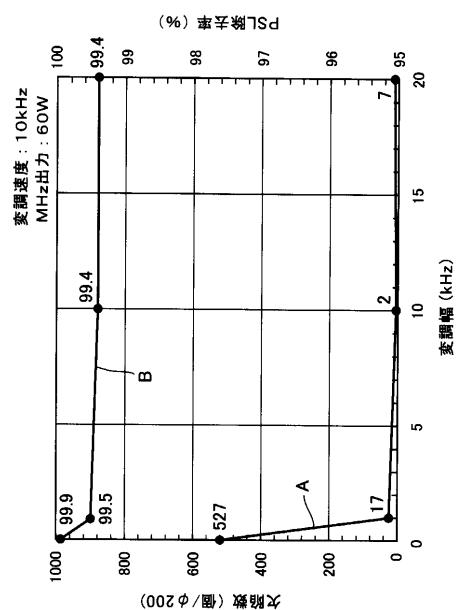
【図4】



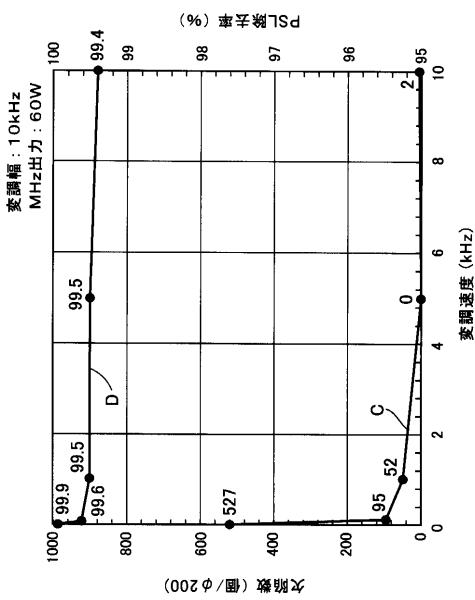
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 松嶋 大輔

神奈川県横浜市栄区笠間町 1000 番地 1 芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所内

(72)発明者 佐藤 修

神奈川県横浜市栄区笠間町 1000 番地 1 芝浦メカトロニクス株式会社横浜事業所内

(72)発明者 速水 直哉

神奈川県横浜市磯子区新磯子町 33 番地 株式会社東芝生産技術センター内

(72)発明者 樋口 晃一

神奈川県横浜市磯子区新磯子町 33 番地 株式会社東芝生産技術センター内

審査官 仲村 靖

(56)参考文献 特開平 06 - 296942 (JP, A)

特開平 10 - 180204 (JP, A)

特表平 05 - 504507 (JP, A)

特開平 10 - 180202 (JP, A)

特開昭 59 - 059278 (JP, A)

特開平 02 - 063580 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

B06B 1/06

B08B 3/12

H01L 21/304